








	<h2>SIJ484DP-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIJ484DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 35A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SIJ484DP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5900 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIJ484DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 35A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	5900 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 35A (Tc) 5W (Ta), 27.7W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	5W (Ta), 27.7W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.3 mOhm @ 10A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	45nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1600pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SIJ484DP-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SIJ484DP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIJ484DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIJ484DP-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SIJ478DP-T1-E3 VISHAY VISHAY POWERPA</p>	 <p>SIJ484DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 35A PPAK SO-8</p>	 <p>SIJ494DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 150V 36.8A SO8</p>	 <p>SIJ478DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 80V 60A PPAK SO-8</p>
 <p>SIJ482DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 80V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SIJ482DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 80V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SIJ494DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 150V 36.8A SO-8</p>	 <p>SIJ800DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 40V 20A PPAK SO-8</p>

heiße Teile

Mehr

⚙ 22251C125KAT1A	⚙ 2PD1820AQ	➔ ACPM-5201-TR1	D ADF4106BRUZ-R7	➔ ADM483EARZ+T
⚙ AP40T03GP-HF	⚙ B39182-D7844-K410	D BC817DPN	➔ BLM18SG260TN1D	➔ CKCL44C0G1H330KT019N
⚙ DMP4050SSS	⚙ DRV8834RGER	⚙ F25L04PA-100PAIG	➔ FAN5358S712X	➔ FOXSD/060-20/TR
D GRM21BR70J225KA01K	⚙ GRM31MR71H474KA01K	⚙ HV6810WG-G	⚙ IMP38HC43EMA	➔ KD40F-80
➔ KSH200TF	➔ LM2575SX-3.3	⚙ M56758FP	⚙ MAX5033AASA+T	➔ MAX6356LSUT
➔ MC79M05BDTRKG	➔ MCP6543-E/MS	D NLC322522T-100K	⚙ P036RH08CK0	⚙ PC4SD11NWPCF
⚙ PD70210AILD-TR	D RM60CZ-H	➔ S9S12G240VLF	➔ SCS751V-40	➔ SIJ400DP-T1-GE3
⚙ SIJ400DP-T1-GE3	⚙ SIJ420DP-T1-GE3	➔ SIJ420DP-T1-GE3	➔ SIJ458DP-T1-E3	➔ SIJ462DP-T1-GE3
⚙ SIJ462DP-T1-GE3	⚙ SIJ484DP-T1-GE3	⚙ SIJ800DP-T1-E3	D T110HF140	➔ TL0324SF11
➔ TLE6289GP	⚙ TM3201-L/TR2	⚙ VE-B63-CU	⚙ VI-711190	➔ W9816G6IH-7

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited